

## 参 考 文 献

- [1] P. Kafalas, J. I. Masters, E. M. E. Murray, *J. Appl. Phys.*, 35, 2349, 1964.
- [2] B. H. Soffer, *J. Appl. Phys.*, 35, 2551, 1964.
- [3] P. P. Sorokin, J. J. Luzzi, J. R. Lankard, G. D. Pettit, *I. B. M. J. Res. Develop.*, 8, 182, 1964.
- [4] О. Д. Дмитриевский, В. С. Ермолаев, А. Н. Теренин, *ДАН СССР*, 114, 751, 1957.

原载 *Оптика и спектроскопия*, 1966, 20, №5 903~905 (周稳观译, 修正礼校)

## 为激光显示寻找較好的扫描器

美国德克萨斯仪器公司正为美国空军罗姆航空发展中心研制磁致伸缩扫描器。这种新途径正作为在军事指挥和控制系统中的大屏激光器显示中的起扫描作用的压电技术的代替物进行试验。为了获得较高的分辨率, 空军对制造每秒 945 行的扫描器很感兴趣; 普通电视扫描速率为每秒 525 行, 因为压电技术不能满足较高的速率。

新扫描器预计于 8 月份交给罗姆航空发展中心, 与该公司把产生多色激光显示器交给这个中心的时间大体相同。

原载 *Electronics*, 1966, 39, №11, 26 (周碧秀译)

## 寬帶光电倍增管

美国西耳凡尼亚电气产品公司已研制出一种用于激光通讯的宽带光电倍增管, 其带宽为 2.5 千兆周, 约为已往接收器的 10 倍。还可以得到更大的带宽。在罗马航空发展中心的发起下研制成的, 此种装置已作成设备, 可对管面欲扫描部分进行电子扫描。

原载 *AW & S T*, 1966, 84, №10, 99 (王克武译)

## 以汽相法生长 GaAs 装置

美国无线电公司已研制出连续操作的制造 GaAs 和 GaAsP 装置的技术。半导体和杂质在汽态时混合; 因此, 此种操作是晶体制造过程的一部分。基于这个过程, 美国无线电公司预言 GaAs 在激光器、微波和电致发光领域中的使用会急骤增加。该公司说, 它已用这种新技术来制造两种装置: 冈恩(Gunn)振荡器, 在 40 兆赫处有 40 毫瓦, 并有 40% 的荷周——在该频率处迄今为止所获得的最高功率——和第一台室温半导体激光器。

1965 年, 德克萨斯仪器公司开始出售以类似生产技术制造的二极管。然而, 在该公司的方法中, 这个过程最少包括一个液体阶段。

原载 *Electronics*, 1966, 39, №11, 25 (周碧秀译)